

Patent Number:

JP4012555

Publication date:

1992-01-17

Inventor(s):

NAGURA HIDEAKI; others: 01

Applicant(s)::

MATSUSHITA ELECTRON CORP

Requested Patent: JP4012555

Application Number: JP19900116249 19900502

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/29

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To make it possible to efficiently dissipate the generated heat by mounting a semiconductor element on a recessed portion or a projected portion to decide a position of a heat sink, and then by packaging it with resin.

CONSTITUTION:A heat sink 1 is formed by a copper plate or an aluminum plate which has high heat conduction. A mounting hole 3 is perforated through the fin of the heat sink, and a recessed portion 4 of the heat-dissipating to decide the position in the central part of the heat sink. A packaged semiconductor element 6 is mounted on the recessed portion 4 of the heat sink by soldering or other methods, and is coated by a package 7 consisting of epoxy resin. In this way, the heat to be generated in a device for semiconductor can be efficiently dissipated.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

JP-A-4-12555 claims a semiconductor device in which a radiation plate having a concave or convex surface for positioning is connected to a semiconductor element.

2

99日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎公開特許公報(A) 平4-12555

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)1月17日

H 01 L 23/29

7220-4M H 01 L 23/36

Α

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

公発明の名称 半導体装置

②特 願 平2-116249

公出 願 平2(1990)5月2日

②発明者 名

英 明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

郊発 明 者 井

正 弘

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

の出願人

松下電子工業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 栗野 重孝

外1名

明 :

1、発明の名称

半導体装置

2、特許請求の範囲

あらかじめパッケージされた半導体素子に、位置決め用の凹面または凸面を設けた放熱板を接換し倒脂でパッケージした半導体装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の科用分野 🕒

本発明は各種電子機器に使用される大電力用の。 半導体装置に関する。

従来の技術

従来、半導体装置の大電力化をはかる方法として、パッケージ自体を大きくし、1Cチップからの故熱をよくする方法、あらかじめパッケージした半導体装置を放熱フィンにネジ締め等で取付け、放熱フィンにより放熱をよくする方法および回路基板に半田付けする方法などがある。

発明が解決しようとする罪職

しかしながら上記の構成では半年体装置内に無

が審視されるという問題点、半導体装置を使用する電子機器の容積によって放無フィンの大きさが 展定されるという問題点および回路基板の大きさ によって放無効果が異なるという問題点を有して いた。

本発明は上記の間暦点を解決するもので、半導体装置内で発生する熱を効率的に放散させることができる半導体装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

この目的を達成するために本発明の半導体装置は、半導体素子に位置決め用の凹面または凸面を 設けた故熱板を接続し樹脂でパッケージした構成 を有している。

作用

この構成によって、半導体素子と放無板を接着 する半田の疲れをよくすると同時に、半導体装置 の取付けを正確に規定できることとなる。

实施例

以下本発明の一実施例について、図面を参照しなから説明する。



第1回に示すように、放無面1は無任事度のよい解析やアルミニウムなどで形成され、その放無フィンには取付け孔3が設けられ、また中央部分には位置決め用の回面4が形成されている。そして、第2回および第3回に示すようにバッケージされた半導体常子6が、この放無板1の回面4に半田付けなどにより取り付けられ、エポキシ側面からなるパッケージ7で被覆されている。

以上のように構成された半導体装置の無抵抗の 御足値を、従来例と比較して第4図に示す。

これから明らかなように、本実施例の無抵抗が 従来例のそれに比べて低く、またそのばらつきも 小さい。

以上のように、本実施例によれば凹面を設けた
数無板に半導体素子を半田付けし樹脂によりパッケージする構成により、無抵抗が大巾に低でした。
生する無を効率的に放散させられるので、大電力
化できる。故無板への取付け位置が正確に規定で
きるので、半導体装置の特性および外形寸法のは
らつきを少なくすることができる。さらに半導体

体接置の一実施例における半導体素子の一例の正面図、同図(b)はその側面図である。第3図(a)は同じく半導体素子の他の例の正面図、同図(b)はその例の正面図である。第4図は本発明の一実施別と従来例の半導体接置の熱抵抗の耐定質の分布図、第5図(a)は本発明の半導体接置の他の実施別における致熱板の正面図、同図(b)はその底面図である。

1 · 2 ······ 故熱板、4 ······· 凹面、5 ······· 凸面、6 ······· 半導体素子、7 ······パッケージ。

代理人の氏名 井理士 東野童孝 ほか1名

設置の投票フィン取付けれを利用してアルミニウムをなどの投票フィンを取付けることにより、一般の大電力化がはかれる。また、あらかじめパッケージした半導体常子に投票仮を付加する機成であるので、製造工程で実際な設備や実施な材料を必要とせず、総合的なコスト低減もできる。

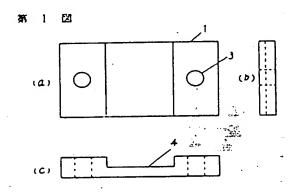
なお実施例において、凹面4を及けた世無板 L ・ を用いたが、第5回に示すように凸面5を及けた 放熱板2を用いてもよい。

吸引の効果

以上の説明からも明らかなように、本発明は、半導体素子を、放無板の位置決め用の凹面または凸面の部分に取付け、さらに樹脂でパッケージした構成であるので、発生する無を効率的に放散させることがで、大電力用半導体装置を実現できるよのである。

4、図面の簡単な説明

第1回(a)は本発明の半導体装置の一変施例における放無板の正面図、同図(b)はその側面図、同図 (c)はその底面図である。第2回(a)は本発明の半導



森 2 四

